ОПТИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ

Магнитооптическая ловушка для атомов Mg, образованная световыми волнами с эллиптической поляризацией

О.Н.Прудников, Д.В.Бражников, А.В.Тайченачев, В.И.Юдин, А.Н.Гончаров

Рассмотрена магнитооптическая ловушка (МОЛ) для атомов ²⁴Mg на замкнутом оптическом переходе ${}^{3}P_{2} \rightarrow {}^{3}D_{3}$ ($\lambda = 383.8$ нм), образованная волнами с эллиптической поляризацией, в $\varepsilon - \theta - \overline{\varepsilon}$ -конфигурации поля. По сравнению с известной МОЛ, образованной волнами с циркулярными поляризациями ($\sigma_{+} - \sigma_{-}$ -конфигурация), в ловушке, образованной полями $\varepsilon - \theta - \overline{\varepsilon}$ -конфигурации, достижимо более глубокое субдоплеровское охлаждение захваченных атомов ${}^{24}Mg$, которое не может быть достигнуто в обычной ловушке, образованной полями $\sigma_{+} - \sigma_{-}$ -конфигурации.

Ключевые слова: магнитооптическая ловушка, субдоплеровское охлаждение, лазерное охлаждение, эллиптическая поляризация.

1. Введение

Возможность использования атомов ²⁴Mg для создания оптических стандартов частоты нового поколения обусловлена наличием узких спектральных линий (так называемые часовые переходы), связанных с запрещенными переходами из основного состояния ¹S₀ на низший триплетный уровень ³P_{0,1,2} (рис.1), а также наличием оптических переходов с достаточно широкими спектральными линиями, доступных для лазерного охлаждения. Так, замкнутый оптический переход ¹S₀ \rightarrow ¹P₁ может быть использован для доплеровского охлаждения атомов ²⁴Mg до температур $T_D = 1.2$ мК. Однако основное состояние рассматриваемого оптического перехода является невырожденным (имеет полный угловой момент J = 0), что делает невозможным применение механизмов субдоплеровского охлаждения.

Для достижения меньших температур было предложено использовать замкнутый оптический переход ${}^{3}P_{2} \rightarrow {}^{3}D_{3}$ ($\lambda = 383.8$ нм) [1, 2]. Поскольку нижнее состояние ${}^{3}P_{2}$ вырождено по проекции углового момента ($J_{g} = 2$), это должно приводить к возможности достижения сверхнизких температур в процессе субдоплеровского лазерного охлаждения [3]. Однако экспериментальная реализация

Поступила в редакцию 7 декабря 2015 г., после доработки – 11 февраля 2016 г.



Рис.1. Схема некоторых энергетических уровней атома ²⁴Mg. Сплошными стрелками указаны оптические переходы, которые могут быть использованы для лазерного охлаждения, штриховыми стрелками обозначены возможные «часовые» переходы.

лазерного охлаждения атомов ²⁴Mg с использованием полей магнитооптической ловушки (МОЛ) о+-о-конфигурации, резонансных оптическому переходу ${}^{3}P_{2} \rightarrow {}^{3}D_{3}$, не привела к ожидаемым результатам [1]. Атомы ²⁴Mg удалось охладить лишь до температуры 1 мК, что даже превышает доплеровский предел температуры лазерного охлаждения (для данного перехода T_D = 425 мкК). Недавний анализ [2] выявил ограничения при лазерном охлаждении атомов ²⁴Mg в полях σ₊-σ₋-конфигурации, связанные с ограниченностью квазиклассических методов описания лазерного охлаждения, что качественно согласуется с результатами работы [1]. Как было указано в [2], это обусловлено недостаточной малостью параметра квазиклассичности для рассматриваемого атомного перехода (отношение энергии отдачи к радиационной ширине верхнего уровня), что является необходимым условием применения квазиклассического приближения [4-8]. В настоящей работе для достижения субдоплеровских

^{*}Доложена на Пятом российско-китайском симпозиуме по лазерной физике и фотонике (RCWLP&P, Новосибирск, 26–30 августа 2015 г.).

О.Н.Прудников, Д.В.Бражников, А.В.Тайченачев. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия, 630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 2; Институт лазерной физики СО РАН, 630090 Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 13/3; e-mail: oleg.nsu@gmail.com

В.И.Юдин, А.Н.Гончаров. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия, 630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 2; Институт лазерной физики СО РАН, 630090 Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 13/3; Новосибирский государственный технический университет, 630073 Новосибирск, просп. К.Маркса, 20

температур лазерно-охлажденных атомов ²⁴Mg мы предлагаем использовать МОЛ, образованную световыми волнами с эллиптическими поляризациями.

2. Основные уравнения

Эволюция атомов в резонансном электромагнитном поле в присутствии магнитного поля описывается уравнением

$$\frac{\partial}{\partial t}\hat{\rho} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\hat{H},\hat{\rho}] - \hat{\Gamma}\{\hat{\rho}\}$$
(1)

для атомной матрицы плотности $\hat{\rho}$. Здесь \hat{H} – гамильтониан атома в поле, а $\Gamma\{\hat{\rho}\}$ описывает релаксацию населенностей и когерентностей энергетических уровней в процессах спонтанного распада (см., напр., [8,9]). К настоящему времени развито множество методов, которые позволяют решить задачу о взаимодействие света с атомами, описываемую уравнением (1), с учетом эффектов отдачи в процессах поглощения и излучения фотонов поля. Все развитые методы методологически разделяются на квазиклассические [4-8] и квантовые [10-17]. Квазиклассические подходы основаны на разложении уравнения (1) по параметру отдачи (отношение импульса фотона $\hbar k$ к дисперсии атомного импульса $\Delta \rho$) и применимы при выполнении ряда условий [4-8]. При этом уравнение для эволюции атомной матрицы плотности $\hat{\rho}$ (1) сводится к квазиклассическому уравнению Фоккера-Планка для распределения плотности атомов в фазовом пространстве $W(r,p) = \text{Tr}\{\hat{\rho}(r,p)\}$:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial t} + \sum_{i} \frac{p_{i}}{M} \nabla_{i} \end{pmatrix} W = -\sum_{i} \frac{\partial}{\partial p_{i}} F_{i}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) W$$

$$+ \sum_{ii} \frac{\partial^{2}}{\partial p_{i} \partial p_{j}} D_{ij}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) W,$$

$$(2)$$

где $E_i(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ и $D_{ij}(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ – декартовы компоненты силы, действующей на движущийся атом, и тензора диффузии атомов в фазовом пространстве соответственно; M – масса атома.

В имеющихся квантовых методах также используются различные упрощения и приближения. В частности, в методе, описываемом в работах [16,17] (так называемая band theory), используется секулярное приближение, которое подразумевает применение полей с достаточно большой отстройкой их частоты $\delta = \omega - \omega_0$ от частоты атомного резонанса ω_0 , когда $\sqrt{U_0/E_{\rm R}} \ll 6|\delta|/\gamma$, где U_0 – глубина оптического потенциала, а $E_{\rm R} = \hbar^2 k^2 / (2M)$ – энергия отдачи (энергия, приобретаемая атомом в результате излучения фотона) [16]. В развитых подходах дополнительно используется приближение, основанное на упрощении исходного уравнения для атомной матрицы плотности, т.е. на редукции исходного уравнения к уравнению для атомной матрицы плотности лишь в нижнем состоянии $\hat{\rho}^{gg}$, что также приводит к ряду ограничений применимости получаемых результатов [18].

Недавно нами был предложен альтернативный метод, позволяющий для одномерной задачи, в одночастичном приближении $n\lambda^3 \ll 1$ (*n* – концентрация холодных атомов, λ – длина волны охлаждающего излучения), численно найти стационарное решение для матрицы плотности атомов (1) с вырожденными по проекции углового момента уровнями в световом поле, образованном встреч-

ными волнами произвольной интенсивности и поляризации. Предложенный метод позволяет точно учесть поступательное движение атомов и эффекты отдачи, возникающие в процессах поглощения и излучения фотонов [18, 19]. В отличие от рассматриваемых ранее подходов, ограничения предложенного квантового подхода определяются лишь рамками применимости квантового кинетического уравнения (1).

3. Пределы лазерного охлаждения атомов ²⁴Mg

Предложенный нами метод позволяет сравнить различные конфигурации световых полей и выявить их параметры, оптимальные для лазерного охлаждения атомов до минимальной температуры. Строго говоря, распределение атомов в электромагнитном поле далеко не максвелловское. Тем не менее мы определим температуру как меру средней кинетической энергии, что в одномерной задаче дает соотношение $k_{\rm B}T = \langle p^2 \rangle / M$. Ниже приведены результаты для температуры вединицах $\hbar \gamma$, где $k_{\rm B} T / (\hbar \gamma) = 1$ соответствует температуре $T \approx 1.28$ мК ($\gamma = 2\pi \cdot 26.7$ МГц для замкнутого оптического перехода ${}^{3}{\rm P}_{2} \rightarrow {}^{3}{\rm D}_{3}$). Дополнительно рассмотрим величину $N_{|p|<3hk}$ – долю холодных атомов с импульсом |p| < 3hk от общего числа атомов, захваченных в ловушке.

Вначале приведем результаты для температуры лазерного охлаждения атомов ²⁴Mg на замкнутом оптическом переходе ${}^{3}P_{2} \rightarrow {}^{3}D_{3}$ в стандартном поле $\sigma_{+}-\sigma_{-}$ -конфи-



Рис.2. Температура атомов ²⁴Мg в поле $\sigma_+ - \sigma_-$ конфигурации (*a*) и доля холодных атомов $N_{|p|<3\hbar k}$ (δ) в зависимости от интенсивности световых волн.

гурации, полученные на основе предложенного нами в [18, 19] метода. Оказывается, температура лазерного охлаждения в этом случае не достигает сверхмалых субдоплеровских значений (рис.2,*a*), что качественно согласуется с результатами работы [1]. Использование lin⊥lin-конфигурации светового поля, сформированного встречными световыми волнами с ортогональными линейными поляризациями, позволяет достичь значительно меньших температур лазерно-охлажденных атомов (рис.3,*a*) и значительно большей доли холодных атомов $N_{|p|<3hk}$. Однако стоит отметить, что данная конфигурация светового поля не может быть использована для реализации МОЛ, поскольку приводит к нулевой магнитооптической силе.

Для глубокого субдоплеровского лазерного охлаждения атомов ²⁴Mg в МОЛ мы предлагаем использовать $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -кофигурацию светового поля (рис.4). Предварительное исследование МОЛ, образованной волнами с эллиптической поляризацией, было проведено нами в работе [9], где мы указали на особенности лазерного охлаждения атомов в таком поле и на специфику работы МОЛ, связанную с отличием поляризаций используемых световых волн от линейной и круговой [20].

На рис.5 приведены зависимости температуры охлажденных атомов ²⁴Mg в поле $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации от интенсивности встречных волн в частном случае их линейной поляризации ($\varepsilon_0 = 0$) при взаимном угле ориентации $\theta = -\pi/4$. Отрицательный знак угла θ выбран для того, чтобы магнитооптическая сила была отрицательной при выходе атомов из точки равновесия (области с нулевым



Рис.3. Температура атомов ²⁴Мg в поле lin⊥lin-конфигурации (*a*) и доля холодных атомов $N_{|p|<3hk}$ (δ) в зависимости от интенсивности световых волн.



Рис.4. Световое поле $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации, образованное встречными волнами с противоположными эллиптическими поляризациями, которые определяются параметрами эллиптичности ε_0 и $-\varepsilon_0$. Параметры $-\pi/4 < \varepsilon_0 < \pi/4$, $\varepsilon_0 = 0$ соответствуют линейной поляризации волны, а $\varepsilon_0 = \pm \pi/4$ – левой и правой циркулярным поляризациям, θ – угол взаимной ориентации между главными осями эллипсов поляризации встречных волн. Для определенности можно положить $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$, при этом положительным углам соответствует поворот эллипса поляризации по часовой стрелке, отрицательным – против.



Рис.5. Температура атомов ²⁴Мд в $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации светового поля при $\theta = -\pi/4$, $\varepsilon_0 = 0$ (*a*) и доля холодных атомов $N_{|p|<3hk}$ (δ) в зависимости от интенсивности световых волн.



Рис.6. Температура атомов ²⁴Mg в поле $\varepsilon - \theta - \overline{\varepsilon}$ -конфигурации при $\theta = -\pi/4$ (*a*) и доля холодных атомов $N_{|p|<3hk}$ (*b*) в зависимости от параметра эллиптичности световых волн ε_0 ; δ , ε – зависимости температуры и доли холодных атомов $N_{|p|<3hk}$ в области малых параметров эллиптичности ε_0 при отстройке $\delta = -\gamma$.

магнитным полем), т.е. формировала захватывающий магнитооптический потенциал МОЛ. На рис.6 приведены зависимости температуры лазерно-охлажденных атомов ²⁴Mg и доли холодных атомов $N_{|p|<3hk}$ от параметра эллиптичности встречных волн. Значения $\varepsilon_0 = \pm \pi/4$ соответствуют левой и правой циркулярным поляризациям световых волн, когда температура принимает значения, соответствующие температуре в $\sigma_+-\sigma_-$ -конфигурации поля. Наблюдаемая асимметрия по параметру эллиптичности ε_0 определяется аномальными поляризационными вкладами в силу трения [20].

В работе [20] нами указывалось, что аномальные вклады в силу трения доминируют в области малых отстроек ($|\delta| \ll \gamma$), поэтому при рассматриваемых отстройках $\delta = -\gamma$ эти вклады малы, и температура охлажденных атомов достигает минимальных значений при поляризациях волн, близких к линейным: $\varepsilon_0 \approx -0.28^{\circ}$ при интенсивности каждой волны $I = 100 \text{ мВт/см}^2$, $\varepsilon_0 \approx -0.86^{\circ}$ при I =200 мВт/см² и $\varepsilon_0 \approx -1.15^{\circ}$ при $I = 300 \text{ мВт/см}^2$. Максимальная доля холодных атомов $N_{|\rho|<3hk}$ достигается для $\varepsilon_0 \approx -2^{\circ}$ при $I = 100 \text{ мВт/см}^2$, для $\varepsilon_0 \approx -5.16^{\circ}$ при I =200 мВт/см² и для $\varepsilon_0 \approx -5.26^{\circ}$ при $I = 300 \text{ мВт/см}^2$.

В табл.1 приведены оптимальные значения параметров эллиптичности и соответствующие им минимальные значения температуры атомов ²⁴Mg при различных интенсивностях встречных волн, формирующих поле в конфигурации $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ при $\theta = -\pi/4$ и отстройке $\delta = -\gamma$.

Табл.1. Оптимальные значения параметров эллиптичности и соответствующие им минимальные значения температуры лазерноохлажденных атомов ²⁴Mg, а также оптимальные значения параметра эллиптичности для достижения наибольшей доли холодных атомов $N_{|p|<3hk}$ при различных интенсивностях встречных волн, формирующих поле в $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации при $\theta = -\pi/4$ и отстройке $\delta = -\gamma$.

<i>I</i> (мВт/см ²)	ε_0 (°)	$k_{\rm B}T/(\hbar\gamma)$	ε_0 (°)	$N_{ p <3\hbar k}$ (%)
100	-0.28	0.097	-2	53.74
200	-0.86	0.118	-5.16	48.16
300	-1.15	0.157	-5.16	43.43

4. Магнитооптический потенциал в поле $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации МОЛ

Нелинейная зависимость магнитооптической силы от величины магнитного поля в единицах отношения зеемановского сдвига Ω_H подуровней нижнего состояния $|J_g = 2, \mu_g = 1\rangle$ к γ показана на рис.7, *а* для $\sigma_+ - \sigma_-$ -конфигурации светового поля и на рис.8, *а* для $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации при $\theta = -\pi/4$ и поляризаций световых волн, близких к линейным. Здесь отстройка $\delta = -\gamma$ и интенсивности световых волн I = 100 мВт/см² соответствуют оптимальным параметрам световых полей рис.5. Зеемановский сдвиг основного состояния $\Omega_H = \gamma$ соответствует магнитному полю H = 12.7 Гс.



Рис.7. Зависимости магнитооптической силы в единицах $hk\gamma$, действующей на атомы ²⁴Mg (*a*), и глубины магнитооптического потенциала в единицах $h\gamma R_w/\lambda$ (*б*) от величины магнитного поля на границе области захвата в единицах Ω_H/γ в поле $\sigma_+-\sigma_-$ -конфигурации ($I = 100 \text{ мBT/см}^2, \delta = -\gamma$).

Стандартная конфигурация МОЛ формируется тремя парами встречных световых волн, распространяющихся вдоль осей x, y, z и обеспечивающих захват атомов во всех трех направлениях в присутствии статического магнитного поля квадрупольной конфигурации [21]. Магнитное поле в точке пересечения пучков (x = 0, y = 0, z = 0) равно нулю и растет по абсолютной величине при смещении от этой точки.

Полагая рост магнитного поля в области захвата атомов линейным, глубину магнитооптического потенциала можно оценить как

$$U^{(H)} = -\frac{R_{\rm w}}{\Omega_H(R_{\rm w})} \int_0^{\Omega_H(R_{\rm w})} \langle F^{(H)}(v=0,\Omega_H) \rangle \mathrm{d}\Omega_H, \qquad (3)$$

где R_w – размер области захвата атомов, определяемый радиусами световых пучков; $\Omega_H(R_w)$ – зеемановский сдвиг на границе области захвата. Глубина магнитооптического потенциала как функция величины магнитного поля на этой границе приведена на рис. 7, δ для σ_+ - σ_- -конфигурации светового поля и на рис. 8, δ для ε - θ - $\bar{\varepsilon}$ -конфигурации при линейном росте магнитного поля в пределах области захвата атомов (3).

Глубина магнитооптического потенциала в поле $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации заметно меньше, чем в поле $\sigma_+ - \sigma_-$ -конфи-



Рис.8. Зависимости магнитооптической силы в единицах $hk\gamma$, действующей на атомы ²⁴Mg (*a*), и глубины магнитооптического потенциала в единицах $h\gamma R_w / \lambda$ (*б*) от величины магнитного поля на границе области захвата в единицах Ω_H / γ в поле $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации для различных параметров эллиптичности ε_0 ($\theta = -\pi/4$, $I = 100 \text{ мBT/см}^2$ и $\delta = -\gamma$).

гурации, но, тем не менее, она остается значительно больше температуры холодных атомов. Так, например, в полях $\varepsilon - \theta - \overline{\varepsilon}$ -конфигурации с $R_w = 0.5$ см и градиентом магнитного поля $\partial H/\partial z = 12.7$ Гс/см (что соответствует $\Omega_H/\gamma \approx 0.5$ на границе области захвата) $U^{(H)} = 0.094\hbar\gamma R_w$ $\times \lambda^{-1} \approx 1.56K$ (рис.8, δ), что намного больше температуры холодных атомов T = 124 мкК при рассматриваемых параметрах ловушки.

Эллиптичность световых полей, приводящая к уменьшению температуры охлажденных атомов в поле $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ конфигурации в результате действия аномальных вкладов в силу трения при $\varepsilon_0 < 0$ и $\theta = -\pi/4$, уменьшает глубину магнитооптического потенциала (рис.8, δ). Так, при $\varepsilon_0 = -3^\circ$ магнитооптическая сила меняет знак, когда магнитное поле достигает критической величины $H_c = 9 \Gamma c$, что соответствует зеемановскому сдвигу $\Omega_H \approx 0.71\gamma$ (рис.8,a).

При оценке числа атомов N_c , захваченных в МОЛ, необходимо учитывать нелинейную зависимость магнитооптической силы $F^{(H)}(v, \Omega_H)$ от величины магнитного поля для атомов с ненулевыми скоростями. Число атомов, захваченных в МОЛ, определяется характерной скоростью v_c , при которой атомы могут быть захвачены магнитооп-



Рис.9. Области параметров (v, Ω_H), в которых магнитооптическая сила становится выталкивающей, в поле $\varepsilon - \theta - \overline{\varepsilon}$ -конфигурации ($\theta = -\pi/4$) при различных эллиптичностях световых волн ε_0 ($I = 100 \text{ мBT/cm}^2$, $\delta = -\gamma$).

тической силой: $N_c \propto v_c^4$ [22]. Для магнитооптической ловушки, образованной волнами $\sigma_+ - \sigma_-$ -конфигурации, критическая скорость захвата $v_c \approx 3.5\gamma/k$ [22], что для ловушки, образованной волнами с радиусами пучков $R_w = 0.5$ см, дает оценку $N_c \approx 7 \times 10^7$ атомов.

Для атомов в МОЛ, образованной в $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации светового поля, при некоторых болыших значениях магнитного поля магнитооптическая сила меняет знак в некоторой области скоростей для медленных атомов (рис.9). Поэтому атомы, попадающие в эту область параметров (v, Ω_H), не могут быть захвачены магнитооптической силой. Границы данных областей определяют критическую скорость захвата v_c при различных величинах магнитного поля. Так, для lin- θ -lin-конфигурации при $\theta = -\pi/4$ и достаточно больших магнитных полях ($\Omega_H/\gamma > 1.5$) критическая скорость захвата падает до ~0.014 γ/k (0.014 м/с), что уменьшает число атомов, захваченных в ловушке, практически до нуля.

Таким образом, при реализации стабильной магнитооптической ловушки в полях $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации необходимы магнитные поля с небольшим пространственным градиентом, таким, чтобы в области захвата магнитное поле не достигало критических значений, при которых магнитооптическая сила для медленно движущихся атомов меняет знак.

Так, например, для стабильной работы ловушки при $I = 100 \text{ MBt/cm}^2$, $\delta = -\gamma \text{ и } \varepsilon_0 = -1^\circ \text{ магнитное поле в обла$ $сти ловушки <math>r < R_w$ не должно превышать критического значения $\Omega_{H}/\gamma \approx 0.98$ ($H_c \approx 12.5 \text{ Cc}$), а при $\varepsilon_0 = 5^\circ$ оно не должно превышать $\Omega_{H}/\gamma \approx 1.63$ ($H_c \approx 20.8 \text{ Cc}$) (рис.9).

На рис. 10 для атомов ²⁴Mg показаны критические значения магнитных полей в зависимости от интенсивности световых волн. При таких значениях полей магнитооптическая сила перестает захватывать атомы, движущиеся с малыми скоростями ($kv < \gamma$), в МОЛ, образованной полем $\varepsilon - \theta - \overline{\varepsilon}$ -конфигурации при различных параметрах ε_0 (угол ориентации $\theta = -\pi/4$).

5. Заключение

В работе предложена МОЛ для атомов ²⁴Mg, работающая на замкнутом оптическом переходе ${}^{3}P_{2} \rightarrow {}^{3}D_{3}$ и образованная волнами с эллиптическими поляризациями в $\varepsilon - \theta - \overline{\varepsilon}$ -конфигурации. В рамках одномерной модели про-



Рис.10. Критические значения магнитных полей, при которых магнитооптическая сила меняет знак, т.е. начинает выталкивать атомы из МОЛ, образованной полем в $\varepsilon - \theta - \overline{\varepsilon}$ -конфигурации, резонансным замкнутому оптическому переходу ${}^{3}P_{2} \rightarrow {}^{3}D_{3}$ атомов ${}^{24}Mg$. Угол ориентации $\theta = -\pi/4$.

веден анализ магнитооптического потенциала, температуры и доли холодных атомов $N_{|p|<3hk}$ в зависимости от интенсивностей световых волн, образующих поле МОЛ, и их поляризаций. Для анализа использован недавно развитый метод [18, 19], позволяющий учесть влияние квантовых эффектов отдачи при взаимодействии атомов с фотонами поля, а также корректно учесть долю холодных атомов, захваченных в оптическом потенциале.

Показано, что использование полей с эллиптическими поляризациями в $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -конфигурации позволяет достичь в несколько раз меньших температур лазерно-охлажденных атомов ²⁴Mg, чем в случае МОЛ, образованной волнами в $\sigma_+ - \sigma_-$ -конфигурации. Так, в поле $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ конфигурации, образованном волнами с эллиптическими поляризациями, ориентированными под углом $\theta = -\pi/4$, с поляризациями, близкими к линейным, можно достичь минимальных температур $T \approx 100$ мкК в достаточно глубоком магнитооптическом потенциале МОЛ с долей ультрахолодных атомов $N_{|p|<3hk} \approx 52\%$ от общего числа захваченных в ловушке атомов $N_c \approx 7 \times 10^7$. По сравнению с МОЛ, сформированной волнами с циркулярными поляризациями $\sigma_+-\sigma_-$, предложенная нами МОЛ с полем $\varepsilon - \theta - \overline{\varepsilon}$ -конфигурации обладает несколько меньшей глубиной оптического потенциала, однако позволяет достичь меньших температур лазерно-охлажденных атомов ²⁴Mg.

Показано, что $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -МОЛ более чувствительна к параметрам светового и магнитного полей, поскольку с ростом магнитного поля магнитооптическая сила для недостаточно медленных атомов может изменить знак, что приведет к ограничению числа атомов, захваченных в МОЛ. Поэтому для стабильной работы $\varepsilon - \theta - \bar{\varepsilon}$ -МОЛ необходим контроль величины магнитного поля, которая не должна превышать критических значений, зависящих от параметров световых полей. Параметры критических значений магнитного поля также приведены в работе.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-12-00054). Работа В.И.Ю. была поддержана грантами Минобрнауки РФ (государственное задание № 2014/139. проект № 825), а также РФФИ (гранты № 14-02-00806, 14-02-00712).

- Riedmann M., Kelkar H., Wubbena T., Pape A., Kulosa A., Zipfel K., Fim D., Ruhmann S., Friebe J., Ertmer W., Rasel E. *Phys. Rev. A*, 86, 043416 (2012).
- Prudnikov O.N., Brazhnikov D.V., Taichenachev A.V., Yudin V.I., Bonert A.E., Il'enkov R.Ya., Goncharov A.N. *Phys. Rev. A*, 92, 063413 (2015).

- 3. Dalibard J., Cohen-Tannoudji C. J. Opt. Soc. Am. B, 6, 2023 (1989).
- Kazantsev A.P., Surdutovich G.I., Yakovlev V.P. Mechanical Action of Light on Atoms (Singapore: World Scientific, 1990).
- Dalibard J., Cohen-Tannoudji C. J. Phys. B: At. Mol. Phys., 18, 1661 (1985).
- 6. Javanainen J. Phys. Rev. A, 44, 5857 (1991).
- 7. Yoo S.M., Javanainen J. Phys. Rev. A, 45, 3071 (1992).
- Прудников О.Н., Тайченачев А.В., Тумайкин А.М., Юдин В.И. ЖЭТФ, 125, 499 (2004).
- Prudnikov O.N., Taichenachev A.V., Tumaikin A.M., Yudin V.I. Phys. Rev. A, 77, 033420 (2008).
- 10. Dum R., Zoller P., Ritsch H. Phys. Rev. A, 45, 4879 (1992).
- 11. Dalibard J., Castin Y., Molmer K. Phys. Rev. Lett., 65, 580 (1992).
- 12. Molmer K., Castin Y., Dalibard J. J. Opt. Soc. Am. B, 10, 524 (1992).
- 13. Castin Y., Dalibard J. *Europhys. Lett.*, **14**, 761 (1991).
- 14. Guo J., Berman P. *Phys. Rev. A*, **48**, 3225 (1993).
- Deutsch I.H., Grondalski J., Alsing P.M. Phys. Rev. A, 56, R1705 (1997).
- Berg-Sorensen K., Castin Y., Molmer K., Dalibard J. *Europhys. Lett.*, 22, 663 (1993).
- Castin Y., Berg-Sorensen K., Dalibard J., Molmer K. *Phys. Rev. A*, 50, 5092 (1994).
- Прудников О.Н., Ильенков Р.Я., Тайченачев А.В., Тумайкин А.М., Юдин В.И. ЖЭТФ, 139, 1074 (2011).
- Прудников О.Н., Тайченачев А.В., Тумайкин А.М., Юдин В.И. ЖЭТФ, 131, 963 (2007).
- Прудников О.Н., Тайченачев А.В., Тумайкин А.М., Юдин В.И. Письма в ЖЭТФ, 70, 439 (1999).
- 21. Чу С. УΦ*H*, **169**, 274 (1999).
- Monroe C., Swann W., Robinson H., Wieman C. Phys. Rev. Lett., 65, 1571 (1990).